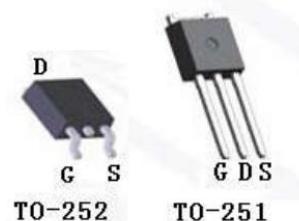


LYNM1A61KT2P (进口芯片) 型 N 沟道 MOS 场效应晶体管

特性

- 参照执行标准: QZJ840611, Q/RBJ1019QZ-2015
- 封装形式: T0-252 (T1)、T0-251 (T2)
- 开关速度快, 输入阻抗高, 驱动功耗小, 安全工作区宽, 温度稳定性好



极限参数

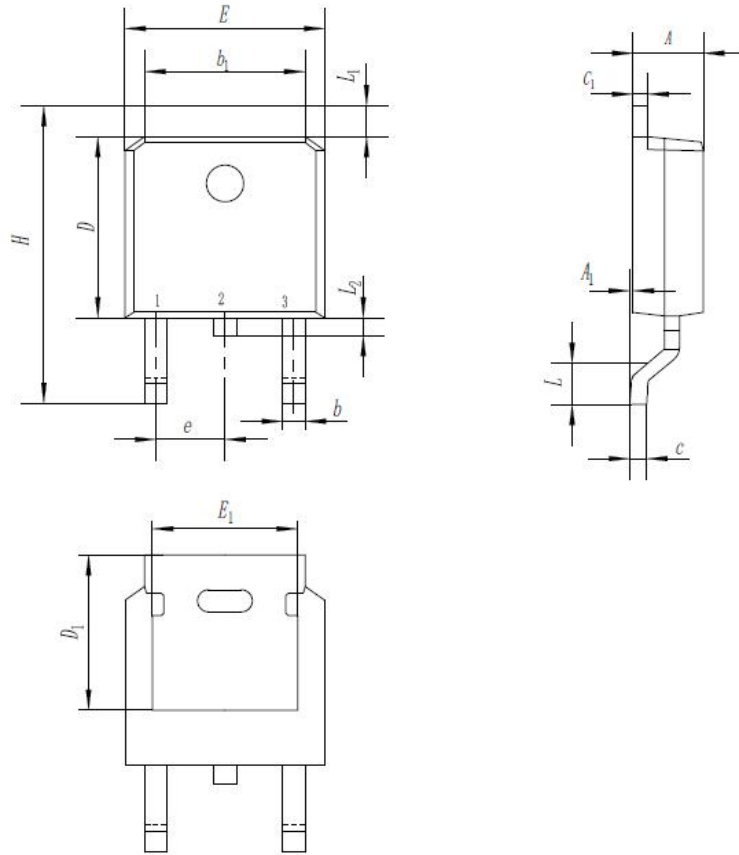
- 贮存温度 T_{stg} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 工作温度 T_{amb} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 焊接温度不超过 260°C , 焊接时间不超过 10 秒

器件型号	额定功率 P_D (W)	漏源电压 BV_{DSS} (V)	栅源电压 V_{GS} (V)	漏极电流 I_D (A)	导通电阻 R_{DS} (Ω)	热阻 $R_{th(j-c)}$ ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)
LYNM1A61KT2P	50 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	1000	± 30	1.6 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	9	2.5

主要电特性 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$	1000	—	—	V
零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=1000\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	—	—	10	μA
		$V_{DS}=800\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, T_c=125^{\circ}\text{C}$	—	—	100	μA
正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=30\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	100	nA
反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=-30\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	—	-100	nA
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	3.0	—	5.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=0.8\text{A}$	—	—	9	Ω
电容	C_{ISS}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	—	—	520	pF
	C_{OSS}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	—	—	52	pF

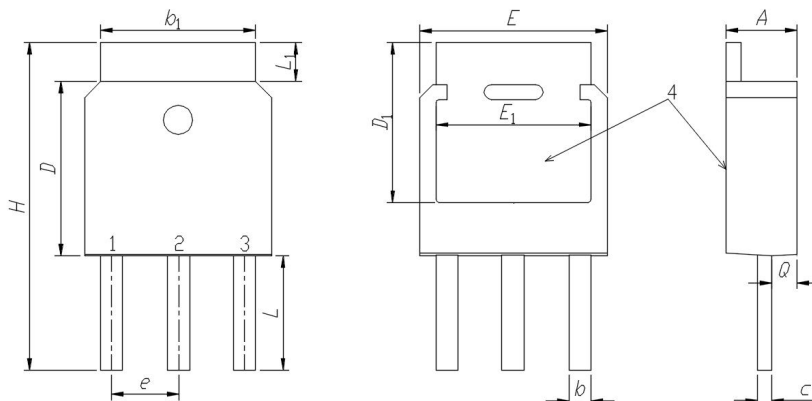
T0-252 封装外形图:



单位：毫米

符号	最小值	最大值	符号	最小值	最大值
A	2.12	2.52	D1	4.95	5.55
A1	0.00	0.18	E	6.06	7.06
b	0.57	0.97	E1	4.60	5.00
b1	5.07	5.67	e	2.19	2.39
c	0.42	0.62	H	9.59	10.59
C1	0.39	0.59	L	1.35	1.75
D	5.60	6.60	L1	0.80	1.20
L2	0.56	0.96			

T0-251 封装外形图:



单位：毫米

符号	最小值	最大值	符号	最小值	最大值
<i>A</i>	2.10	2.50	<i>E</i>	6.35	6.80
<i>b</i>	0.57	0.97	<i>E₁</i>	5.14	5.54
<i>b₁</i>	5.07	5.67	<i>e</i>	2.19	2.39
<i>c</i>	0.40	0.60	<i>H</i>	9.59	10.59
<i>D</i>	5.90	6.30	<i>L</i>	8.90	9.65
<i>D₁</i>	4.95	5.55	<i>L₁</i>	0.50	1.27
<i>Q</i>	0.90	1.14			